

УДК 535.37 : 548.0

**ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК  
ШИРОКОПОЛОСНОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ИОНОВ Еу  
И Yb В КРИСТАЛЛАХ СО СТРУКТУРОЙ ФЛЮОРИТА**

E. Г. Рейт

Исследованы спектрально-кинетические и поляризационные характеристики широкополосной люминесценции ионов  $\text{Eu}^{2+}$  и  $\text{Yb}^{2+}$  в чистых и смешанных кристаллах со структурой флюорита в интервале температур 4–150 К. В ряде случаев обнаружено, что наиболее характерные изменения спектров люминесценции и поляризации происходят в смешанных кристаллах при очень незначительных отклонениях состава от чистого кристалла. Обсуждаются процессы с переносом заряда и эффект Яна–Теллера в люминесцирующем состоянии как возможные причины необычных свойств рассматриваемых систем.

Двухвалентные ионы Eu и Yb в некоторых кристаллах со структурой флюорита обнаруживают необычную для редкоземельных (РЗ) ионов широкополосную люминесценцию с аномально большим стоксовым сдвигом [1]. Имеется ряд работ, в которых исследуются спектрально-кинетические, поляризационные [2], пьезо-спектроскопические [3], магнито-оптические [4] характеристики иона  $\text{Yb}^{2+}$  в кристалле  $\text{CaF}_2$ . В работе [5] закономерности в изменении спектров в смешанных кристаллах, общие для ионов Yb и Eu, сопоставляются с окислительно-восстановительными свойствами основ. Ниже будут изложены экспериментальные результаты по люминесценции ионов Yb и Eu в чистых и смешанных кристаллах со структурой флюорита.

И т т е р б и й. Спектрально-кинетические характеристики люминесценции иона  $\text{Yb}^{2+}$  в  $\text{CaF}_2$  известны. Предполагается, что люминесцируют два близких ( $\Delta \approx 30 \text{ см}^{-1}$ ) состояния. Нижнее состояние невырождено и имеет вероятность излучательного распада  $7.5 \cdot 10^1 \text{ с}^{-1}$ , верхнее имеет двукратное вырождение и вероятность излучательного распада  $2.5 \cdot 10^3 \text{ с}^{-1}$ . Эта особенность энергетической структуры приводит к изменению кинетики без изменения выхода при низких температурах и смешению полосы люминесценции на  $\sim 600 \text{ см}^{-1}$  в область меньших энергий при переходе к гелиевой температуре. При низких температурах обнаружена анизотропия спектров люминесценции [2].

Исследование кристалла  $\text{SrF}_2\text{-Yb}^{2+}$ , выполненное в данной работе, показало, что полоса люминесценции при  $T=4.2$  и 77 К имеет максимумы около  $\nu=12\,670$  и  $13\,700 \text{ см}^{-1}$  соответственно. Ход интенсивности и длительности люминесценции показан на рис. 1. Из приведенных результатов следует, что при  $T=4.2$  К вероятность тушения люминесценции<sup>1</sup> пре-восходит вероятность излучательного распада с нижнего уровня. Повышение температуры приводит к заселению верхнего уровня с большей ве-

<sup>1</sup> При исследовании температурной зависимости интенсивности свечения учтено изменение спектрального состава. Зависимость одинакова при возбуждении в разных полосах поглощения иона  $\text{Yb}^{2+}$ .

роятностью излучательного распада и возрастанию выхода люминесценции. Вероятность излучательного распада может быть определена из отношения интенсивности к длительности люминесценции с учетом того факта, что длительность люминесценции  $\text{Yb}^{2+}$  при  $T=77$  К в кристалле  $\text{SrF}_2$  в  $\sim 15$  раз меньше, чем в  $\text{CaF}_2$ . По температурной зависимости суммарной вероятности излучательного распада можно определить расстояние между люминесцирующими состояниями  $\Delta=27 \text{ см}^{-1}$  и вероятность излучательного распада с каждого уровня в отдельности:  $A_1=5.8 \cdot 10^1$  и  $A_2=7.9 \cdot 10^3 \text{ с}^{-1}$ .<sup>2</sup> Для обоих кристаллов смещение полосы люминесценции при переходе к гелиевой температуре значительно превосходит разность в энергии люминесцирующих уровней. Это, вероятнее всего, означает,

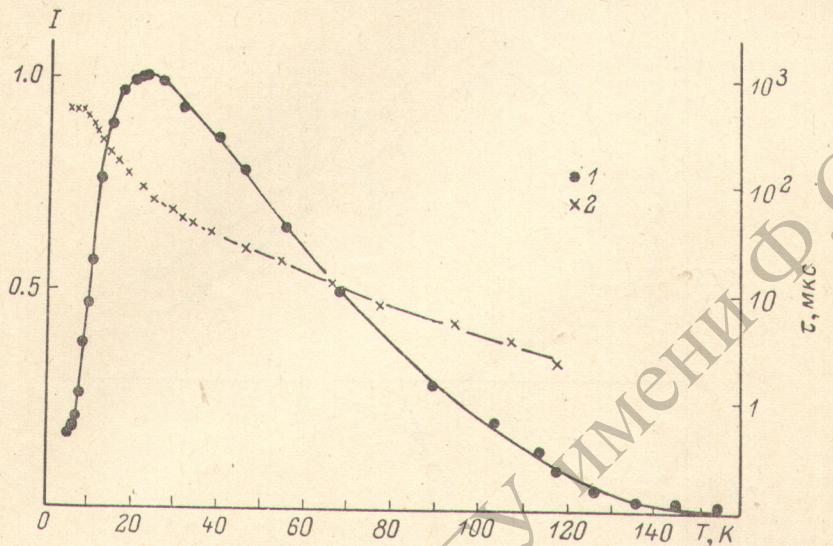


Рис. 1. Температурная зависимость интенсивности (1) и длительности (2) люминесценции для кристалла  $\text{SrF}_2\text{-Yb}^{2+}$ .

что адиабатические потенциалы этих состояний имеют минимумы при различных значениях ядерных координат.

Были проведены исследования степени поляризации при возбуждении поляризованным светом. Для всех кристаллов, исследованных в данной работе, поляризационные измерения проводились в одинаковых условиях. Пластина кристалла (толщиной от 1 до 3 мм), вырезанная перпендикулярно оси  $C_4$ , помещалась в гелиевый криостат перпендикулярно оптической оси схемы. С помощью поляроида, расположенного за выходной щелью монохроматора, выделяющего нужную длину волн, возбуждающего света, можно было менять положение вектора  $E$  возбуждающего света в плоскости пластиинки (азимутальная зависимость). За кристаллом помещался врачающийся поляроид и фотоумножитель. Регистрировались переменный ( $P_{\parallel}-P_{\perp}$ ) и постоянный ( $P_{\parallel}+P_{\perp}$ ) сигналы. Для спектрального разделения света люминесценции использовались фильтры.

На рис. 2 приведена температурная зависимость степени поляризации кристалла  $\text{SrF}_2\text{-Yb}^{2+}$  при возбуждении светом в длинноволновой полосе поглощения с вектором  $E$  параллельным оси  $C_4$ . Азимутальная зависимость соответствовала ориентации излучателей по оси  $C_4$ . Ориентация не меняется с температурой.

Была исследована также степень поляризации люминесценции кристалла  $\text{Ca}_{0.95}\text{Sr}_{0.05}\text{F}_2\text{-Yb}^{2+}$  (рис. 2). Для коротковолнового участка полосы

<sup>2</sup> Вероятности излучательного распада вычислены с учетом вырождения люминесцирующих состояний и в предположении, что квантовый выход люминесценции  $\text{CaF}_2\text{-Yb}^{2+}$  при  $T=77$  К равен единице. Для  $\text{CaF}_2\text{-Yb}^{2+}$  в настоящей работе получены следующие величины:  $\Delta=33 \text{ см}^{-1}$   $A_1=1.7 \cdot 10^2$  и  $A_2=4.3 \cdot 10^3 \text{ с}^{-1}$ .

люминесценции получена такая же зависимость, как и для кристалла  $\text{CaF}_2\text{-Yb}^{2+}$ . Поляризация отрицательна и спадает в области 50—60 К. Зависимость, полученная для длинноволнового участка полосы люминесценции, за который ответственны центры, содержащие ион Sr в ближайшем окружении, почти совпадает с зависимостью для  $\text{SrF}_2\text{-Yb}^{2+}$ , за исключением низкотемпературного участка, который может быть искажен вкладом люминесценции ионов  $\text{Yb}^{2+}$ , окруженных только ионами кальция.

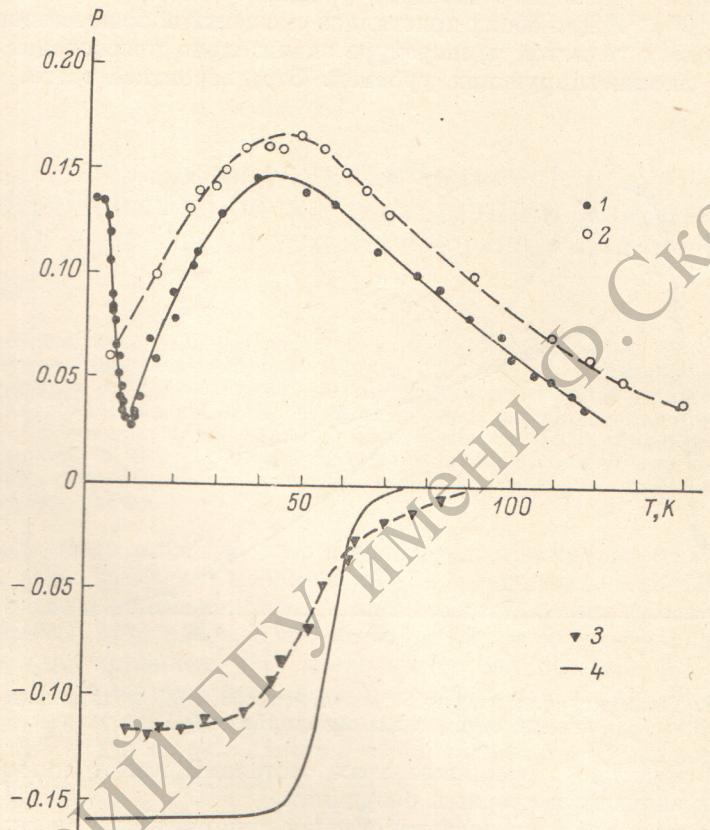


Рис. 2. Температурная зависимость степени поляризации люминесценции.

1 —  $\text{SrF}_2\text{-Yb}^{2+}$ ; 2 —  $\text{Ca}_{0.95}\text{Sr}_{0.05}\text{F}_2 = \text{Yb}^{2+}$ ,  $\lambda_{\text{люм}} \geq 7000 \text{ \AA}$ ; 3 —  $\text{Ca}_{0.95}\text{Sr}_{0.05}\text{F}_2 = \text{Yb}^{2+}$ ,  $\lambda_{\text{люм}} \approx 5500 \text{ \AA}$ ; 4 —  $\text{CaF}_2\text{-Yb}^{2+}$  [2].

Таким образом, дальнейшее возрастание числа ионов Sr в ближайшем окружении иона  $\text{Yb}^{2+}$  уже не меняет поляризационные характеристики,<sup>3</sup> хотя и приводит к понижению адиабатического потенциала, смещению полосы люминесценции в длинноволновую область, возрастанию тушения и сокращению длительности люминесценции.

Европий. В работе [5] на системе  $\text{Sr}_{1-x}\text{Ba}_x\text{F}_2\text{-Eu}^{2+}$  наблюдался переход от структурированного спектра  $\text{Eu}^{2+}$  в  $\text{SrF}_2$  (переход  $4f^65d \rightarrow 4f^7$ ,  $\lambda_{\text{макс.}} \sim 4200 \text{ \AA}$ ) к широкополосному свечению  $\text{Eu}^{2+}$  в  $\text{BaF}_2$  ( $\lambda_{\text{макс.}} \sim 6000 \text{ \AA}$ ). Исследование спектров возбуждения и кинетики смешанных кристаллов показало, что свечение неоднородно, характер его существенно зависит от структуры ближайшего окружения. Добавление  $\text{BaF}_2$  к  $\text{SrF}_2$  сразу ведет к появлению широкополосного свечения, которое до  $x=0.1$

<sup>3</sup> Положительная поляризация ( $\sim 7.5\%$  при  $T=44 \text{ K}$ ) наблюдается и на длинноволновом участке полосы люминесценции чистого  $\text{CaF}_2\text{-Yb}^{2+}$ , но деполяризация начинается при одних и тех же температурах для всех  $\lambda_{\text{люм.}}$  независимо от знака поляризации и ее абсолютной величины.

растет по интенсивности с неизменным спектральным распределением, а затем начинает смещаться в длинноволновую область. Длительность люминесценции при  $T=4.2$  К на длинноволновом участке ( $\tau \approx 1$  мкс) заметно отличается от длительности люминесценции из  $4f^65d$ -конфигурации ( $\tau=0.6$  мкс) даже при самых малых  $x$  ( $\leq 0.01$ ). Возрастание  $x$  до единицы (т. е. переход к кристаллу  $\text{BaF}_2$ ) увеличивает  $\tau$  лишь до 1.8 мкс. Спектры возбуждения для разных длин волн люминесценции одного кристалла обладают теми же характерными различиями, что и спектры

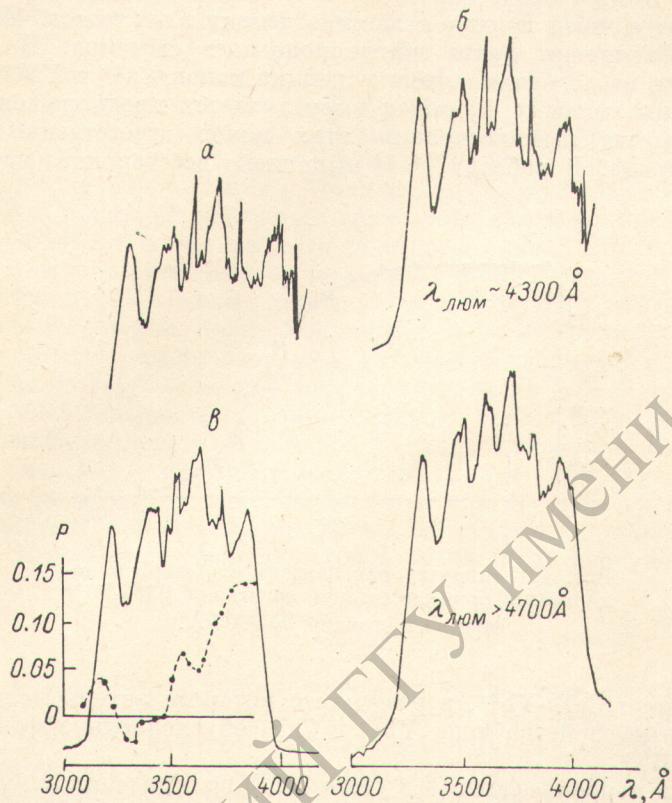


Рис. 3. Спектры возбуждения люминесценции кристаллов  $\text{SrF}_2\text{-Eu}^{2+}$  (а),  $\text{Sr}_{0.997}\text{Ba}_{0.003}\text{F}_2\text{-Eu}^{2+}$  (б) и  $\text{BaF}_2\text{-Eu}^{2+}$  (в).

Записаны с одним источником без учета спектрального распределения числа фотонов. Поглощение в наиболее интенсивной коротковолновой полосе для всех образцов не превосходило 60 %. Штриховой линией показана зависимость степени поляризации люминесценции  $\text{BaF}_2\text{-Eu}^{2+}$  от длины волны возбуждающего света.  $T=4.2$  К.

возбуждения разных кристаллов в крайних точках ряда (рис. 3). Спектры возбуждения широкополосной люминесценции не меняются по положению до  $x=0.1$  и лишь при  $x > 0.1$  начинают смещаться в область больших энергий. Таким образом, появление иона бария в окрестности иона  $\text{Eu}^{2+}$  радикально меняет спектр люминесценции, кинетику и спектр возбуждения. В то же время возрастание концентрации  $\text{Ba}$  до 0.1 только увеличивает число центров с широкополосной люминесценцией, оставляя без изменения все характеристики этих центров. Следовательно, влияние иона  $\text{Ba}^{2+}$  проявляется лишь в первой катионной сфере (12 позиций по  $C_2$ ). Этот вывод подтверждается расчетом числа центров, возмущенных ионом  $\text{Ba}^{2+}$ , и центров с однородным окружением в предположении статистического распределения бария по решетке. Получается хорошее согласие с экспериментом [5], если ближайшим окружением считать первую катионную сферу и значительное расхождение (более, чем в 10 раз для  $x=0.3$ ), если включить вторую катионную сферу (6 позиций по  $C_4$ ).

Для кристалла  $\text{BaF}_2\text{-Eu}^{2+}$  была исследована зависимость степени поляризации люминесценции при возбуждении поляризованным светом с вектором  $E$ , параллельным оси  $C_4$ , от температуры (рис. 4) и от длины волны возбуждающего света (рис. 3). Азимутальная зависимость соответствовала ориентации излучателей по оси  $C_4$ . В кристаллах  $\text{SrF}_2\text{-Eu}^{2+}$  и  $\text{Sr}_{0.985}\text{Ba}_{0.015}\text{F}_2\text{-Eu}^{2+}$  никаких поляризационных явлений обнаружено не было.

**Обсуждение.** Изложенные выше результаты по люминесценции ионов  $\text{Eu}^{2+}$  и  $\text{Yb}^{2+}$  свидетельствуют о сходстве наблюденных явлений и оправдывают единый подход к люминесценции этих ионов. Имеется два варианта объяснения факта широкополосного свечения. В работе [5] на основании исследования люминесценции ионов  $\text{Eu}^{2+}$  и  $\text{Yb}^{2+}$  в смешанных щелочноземельных фторидах высказывается предположение, что за широкополосную люминесценцию этих ионов ответственно состояние переноса заряда. В работах [2, 3] выполнено всестороннее исследование

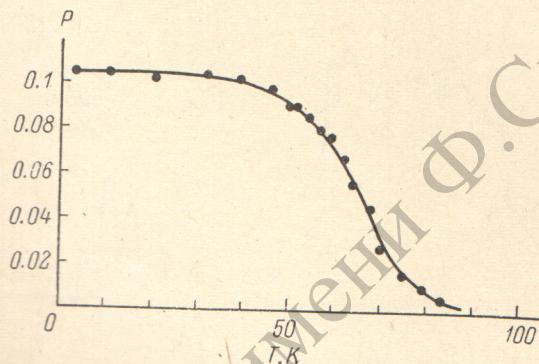


Рис. 4. Температурная зависимость степени поляризации люминесценции кристалла  $\text{BaF}_2\text{-Eu}^{2+}$  при возбуждении  $\lambda=3700 \text{ \AA}$ .

люминесценции  $\text{CaF}_2\text{-Yb}^{2+}$ , в результате которого авторы делают вывод, что необычные свойства иона  $\text{Yb}^{2+}$  в  $\text{CaF}_2$  обусловлены эффектом Яна—Теллера (ЭЯТ).

В рамках первой модели (без учета ЭЯТ) поляризация люминесценции возможна только при ассоциации РЗ иона с каким-либо дефектом кристалла. Скрытая анизотропия, которая обнаруживается в поляризационных измерениях при низких температурах, исчезает при повышении температуры, если время переориентации дефекта становится сравнимым с длительностью люминесценции. Однако экспериментальные значения для вероятностей переориентации  $V_k$ -центров в  $\text{BaF}_2$  [6] ( $\tau^{-1}=3.2 \times 10^{12} e^{-\Delta E/kT} \text{ c}^{-1}$ ,  $\Delta E=0.3 \text{ эВ}$ ; при  $T=100 \text{ K}$   $\tau^{-1}=2.10^{-3} \text{ с}^{-1}$ ) и  $M$ -центров в  $\text{CaF}_2$  [7] ( $\tau^{-1}=5 \cdot 10^{13} e^{-\Delta E/kT} \text{ c}^{-1}$ ,  $\Delta E=0.98 \text{ эВ}$ ) оказываются слишком малыми даже для иона  $\text{Yb}^{2+}$ . Более сложные образования ( $H$ -центр), обеспечивающие анизотропию по  $C_4$ , имеют, по-видимому, скорости еще меньше.

Низкотемпературная анизотропия в системах с ЭЯТ — явление достаточно распространенное. Однако модель ЭЯТ в  $4f^65d$ -конфигурациях ионов  $\text{Eu}^{2+}$  и  $\text{Yb}^{2+}$  не в состоянии объяснить радикальные изменения, которые возникают в спектрах при незначительных примесях ионов Sr к  $\text{CaF}_2$  и Ba к  $\text{SrF}_2$ . Известно, что при сильном электронно-колебательном взаимодействии дефект по соседству с люминесцирующим центром может сохранить без изменения все проявления ЭЯТ (в том числе и ориентационные). Однако понижение симметрии до  $C_2$  (симметрия с одним замещенным катионом), которая снимает всякое вырождение, не может резко изменить или тем более стимулировать возникновение ЭЯТ, если этот эффект не наблюдался в той же основе для центров с более симметричным окружением. Необходимо поэтому предположить, что изменение окружения

в катионной сфере ведет к появлению нового люминесцирующего состояния с резко отличными характеристиками. Это отчетливо наблюдается для иона  $\text{Eu}^{2+}$ .

В сущности аналогичный эффект имеет место и для иона  $\text{Yb}^{2+}$ , но проявляется только на поляризационных характеристиках, так как в рассматриваемых системах проследить за переходом от одного типа свечения к другому невозможно. Сам факт поляризации люминесценции и даже разные знаки поляризации для кристаллов  $\text{CaF}_2\text{-Yb}^{2+}$  и  $\text{SrF}_2\text{-Yb}^{2+}$  в принципе объясняются в рамках ЭЯТ. Если, следуя работе [3], продолжить аналогию между ионом  $\text{Yb}^{2+}$  и ртутеподобными ( $M^+$ ) ионами в щелочно-галоидных кристаллах (ЩГК), можно предположить сложную форму адиабатического потенциала с двумя типами минимумов.<sup>4</sup>

Влияние же небольших примесей на знак поляризации люминесценции  $\text{Yb}^{2+}$  в смешанных кристаллах в рамках ЭЯТ остается непонятным, так как тип анизотропии по  $C_4$  остается, хотя дефект, вызывающий изменение знака, ориентирован по  $C_2$ . Понижение точечной симметрии центра не может быть причиной изменения знака, так как в кристалле  $\text{SrF}_2$  поляризация также положительна. По-видимому, замена одного из иона Са ионом Sr достаточно резко меняет энергию люминесцирующего состояния, что при наличии ЭЯТ может привести к деформации адиабатического потенциала и изменению поляризационных характеристик.

Заслуживает внимания минимум на кривой температурной зависимости степени поляризации для кристалла  $\text{SrF}_2\text{-Yb}^{2+}$ . Так как ориентация излучателей не меняется с температурой, можно было бы предположить, что низкотемпературная деполяризация связана с возрастанием туннельных переходов между минимумами. Но в данном случае подобное рассуждение не является объяснением, так как в сущности аномальная зависимость степени поляризации заменяется также аномальной зависимостью для вероятности туннельных переходов  $W$  по формуле

$$W(T) - W(0) \sim \frac{P(0) - P(T)}{P(T)\tau(T)^5}$$

получается резкое возрастание вероятности туннельных переходов в интервале 4–10 К, а затем пологий спад]. В то же время, если сравнить рис. 1 и 2, нетрудно заметить, что поляризация уменьшается в том же интервале температур, в котором появляется люминесценция с верхнего уровня, и возвращается к исходному значению при  $T=40$  К, когда верхний уровень практически заселен. Это наводит на мысль, что падение поляризации связано с процессом перехода между двумя люминесцирующими состояниями. При малой скорости этого процесса, по-видимому, проявляется люминесценция из промежуточных нестабильных состояний адиабатического потенциала с другой ориентацией. Такая ситуация возможна только при достаточно сильном различии адиабатических потенциалов двух люминесцирующих состояний (низкотемпературный сдвиг полос люминесценции свидетельствует о том же), что объяснить в рамках ЭЯТ трудно, если предполагать нижнее состояние невырожденным.<sup>6</sup>

Из проведенного анализа ясно, что рассмотренные модели для центров  $\text{Eu}^{2+}$  и  $\text{Yb}^{2+}$  дополняют одна другую. Изменение катионного окружения существенно влияет на энергию и характеристики люминесцирующего

<sup>4</sup> Для ионов  $M^+$  в ЩГК выполнен ряд теоретических работ [8], в которых доказана возможность появления нескольких типов минимумов на адиабатическом потенциале и сформулированы условия их существования. Но и для этих ионов ситуация остается сложной и не вполне однозначной. Последние работы по влиянию всестороннего сжатия на спектры  $M^+$  в ЩГК показали, что излучают и поглощают разные состояния (зависимости максимумов полос от давления, состава кристаллов, корреляции с диэлектрическими проницаемостями) [9].

<sup>5</sup> Формула получена для трех эквивалентных анизотропных излучателей, ориентированных по осям  $C_4$ .

<sup>6</sup> С аналогичной трудностью столкнулись авторы работы [4] при попытке объяснения спектрального хода магнитной циркулярной поляризации в  $\text{CaF}_2\text{-Yb}^{2+}$ .

состояния и понять это влияние без привлечения окислительно-восстановительных свойств решетки и составляющих ее ионов не представляется возможным. С другой стороны, низкотемпературная анизотропия есть следствие ЭЯТ. Более того ЭЯТ на данных системах, особенно для иона  $\text{Yb}^{2+}$ , проявляется, по-видимому, настолько разнообразно, что понятие «уровень» теряет смысл и вместо него корректнее пользоваться понятием «лист адиабатического потенциала». Разные минимумы одной поверхности могут обладать совершенно разными поляризационными, релаксационными и пр. характеристиками.

Дальнейшая разработка и конкретизация модели ввиду необычайной гибкости используемых представлений целесообразна только на количественном уровне: построение орбиталей, включающих оболочки соседних атомов, исследование влияния  $4j^k5d$ -конфигурации РЗ иона на свойства этого состояния; расчет адиабатических потенциалов люминесцирующего состояния с учетом ЭЯТ применительно к данной структуре.

Автор выражает благодарность П. П. Феофилову за обсуждение работы и В. Н. Баклановой за выращивание кристаллов.

### Литература

- [1] А. А. Каплянский, П. П. Феофилов. Опт. и спектр., 13, 235, 1962; П. П. Феофилов. Опт. и спектр., 1, 992, 1956.
- [2] А. А. Каплянский, В. Н. Медведев, П. Л. Смолянский. Опт. и спектр., 41, 1043, 1976.
- [3] А. А. Каплянский, В. Н. Медведев, П. Л. Смолянский. Опт. и спектр., 42, 136, 1977.
- [4] В. С. Запасский, П. П. Феофилов. Опт. и спектр., 41, 1051, 1976.
- [5] Е. Г. Реут. Опт. и спектр., 40, 99, 1976.
- [6] J. H. Beaumont, W. Haynes, D. L. Kirk, G. P. Summers. Proc. Roy. Soc., 15, A315, 69, 1970.
- [7] J. H. Beaumont, W. Haynes. Proc. Roy. Soc., A309, 41, 1969.
- [8] M. Bassi, A. Ranfagni, M. P. Fontana, G. Viliani. Phys. Rev., B, 11, 3052, 1975.
- [9] W. D. Drotting, H. G. Drickamer. Phys. Rev., B, 13, 4568, 4592, 1975.

Поступило в Редакцию 5 октября 1977 г.